

Datenblatt

F-SMA DIP-Gehäuse 660nm Sender

LED 660nm 10MBits/s

1 Allgemeine Beschreibung

Das Bauelement ist speziell geeignet für Anwendungen mit Standard 1mm Kunststofflichtwellenleiter. Bestückt mit einer schnellen 660nm LED die über eine hohe optische Ausgangsleistung verfügt, ist das Bauelement eine gute Alternative in Datenübertragungssystemen mit Kunststofflichtwellenleiter.

2 Anwendungen____

Aufgrund der hohen Datenübertragungsrate von 10 MBit/s (mit geeigneter Treiberschaltung), den guten optischen Eigenschaften und der einfachen Anschlußtechnik des Lichtwellenleiters, findet das Bauelement eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten:

- optische Netzwerke
- Industrieelektronik
- Leistungselektronik
- Automotive
- Consumer Elektronik
- Lichtschranken



Bild 1 DIP-Gehäuse

5 Eigenschaften___

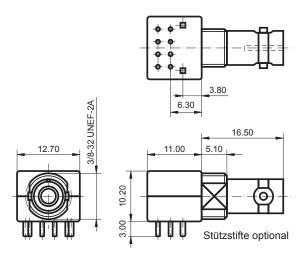
- 660nm LED
- 200µW Ausgangsleistung bei 10mA
- 10MBit/s (mit geeigneter Treiberschaltung)
- F-ST Anschluß Metall
- geeignet für Kunststofflichtwellenleiter und HCS®-Faser
- Kunststoffgehäuse
- optional mit Stützstiften
- geeignet f
 ür automatische Best
 ückung
- wellenlötfähig

3 Bestellinformation _____

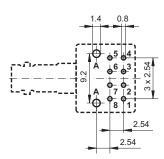
AusführungBestellnummer660nm Sender905SE660ST003660nm Sender mit Stützstifen905SE660ST004

4 Maßzeichnungen

Gehäuse



Bohrplan für PCB



Schaltbild 2

Ansicht: Bestückungsseite Durchmesser der Bohrungen: Pin 1..8 = 0.8mm Stützstifte (Option) = 1.4mm

Pin-Nr.	Funktion	
2	Anode	
3	Kathode	
1, 4, 5, 6, 7, 8	NC	



Electronics | OptoElectronics | Rev. A01 | T05SE660ST003

LED 660nm 10MBits/s

6 Grenzwerte

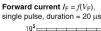
Belastungen die über die als `Grenzwerte` angegebenen hinausgehen können das Bauelement dauerhaft beschädigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlässigkeit des Bauelementes darunter leiden kann.

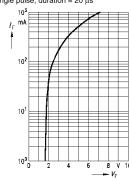
Parameter	Wert	Einheit
Betriebstemperatur	-40 bis +80	°C
Lagertemperatur	-55 bis +100	°C
Sperrschichttemperatur	100	°C
Löttemperatur 2mm vom Gehäuse, t ≤ 5s	260	°C
Sperrspannung	3	V
Durchlaßstrom	50	mA
Stoßstrom t ≤ 10µs, D=0	1	А
Verlustleistung	120	mW
Wärmewiderstand	450	K/W

7 Technische Daten

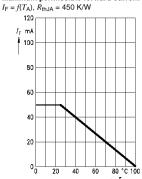
Parameter	Wert	Einheit
Wellenlänge λ	660	nm
Spektrale Bandbreite Δλ	25	nm
	100 100	ns ns
Kapazität (V _R =0V)	30	pF
Durchlaßspannung V _F (I _F =50mA)	2.1 (<2.8)	V
Ausgangsleistung P_{OUT} in 1mm Faser (I_F =10mA)	200 (>100)	μW
Temperaturkoeffizient P _{OUT}	-0.4	%/K
Temperaturkoeffizient V _F	-3	mV/K
Temperaturkoeffizient λ	0.16	nm/K

8 Kennlinien₋

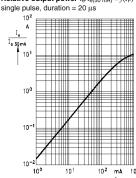




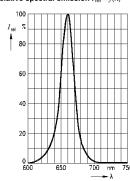
Maximum permissible forward current



Relative output power $I_e/I_{e(50 \text{ mA})} = f(I_F)$



Relative spectral emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$



Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.